

## 高速／低消費 150mAレギュレータ

NO. JA-136-120404

### ■ 概要

R1126NシリーズはCMOSプロセス技術を用いて開発した、高リップル除去率、低入出力電圧差、高精度、低消費電流の正電圧ボルテージレギュレータICで、基準電圧源、誤差増幅器、出力電圧設定用抵抗網、短絡電流制限回路、チップイネーブル回路、等から構成されています。

出力電圧はIC内で固定されています。CMOSプロセスによる低消費電流特性に加え、低オン抵抗トランジスタ内蔵による低入出力電圧差、および、チップイネーブル機能により電池の高寿命化に対応できます。また、従来のCMOSプロセスによるレギュレータに比べ、リップル除去率、入力過渡応答、負荷過渡応答特性に優れ、携帯通信機器の電源に適した製品となっております。

R1114xシリーズ（TYP. 75mA）に比べて飛躍的に低消費電流で、R1162x/R1163xシリーズ（TYP. 6 $\mu$ A）のようにECOモードに切り替えることなく低消費電流を実現しています。出力電圧は $\pm 1.5\%$ （ $1.5V \leq V_{OUT} \leq 3.0V$ 時）の高精度です。

パッケージはSOT-23-5に実装することにより、高密度実装を狙った製品となっております。

また、端子配置の異なるR1116Nシリーズもご用意しています。

### ■ 特長

- 低消費電流..... TYP. 10 $\mu$ A
- 低消費電流（スタンバイ時）..... TYP. 0.1 $\mu$ A
- 入出力電圧範囲..... 1.8V~6.0V
- 出力電圧範囲..... 1.5V~4.0V
- 入出力電圧差..... TYP. 0.29V（ $I_{OUT}=150mA$ 、 $V_{OUT}=2.8V$ ）
- リップル除去率..... TYP. 70dB（ $f=1kHz$ 、 $V_{OUT}=3.0V$ ）  
TYP. 53dB（ $f=10kHz$ ）
- 出力電圧精度が高い.....  $\pm 1.5\%$ （ $1.5V \leq V_{OUT} \leq 3.0V$ ）、 $\pm 2.0\%$ （ $V_{OUT} > 3.0V$ ）
- 出力電圧の温度係数が小さい..... TYP.  $\pm 100ppm/^{\circ}C$
- 入力安定度が良い..... TYP. 0.02%/V
- パッケージ..... SOT-23-5
- 短絡電流制限回路内蔵..... TYP. 40mA
- セラミックコンデンサ対応.....  $C_{IN}=C_{OUT}$ =セラミック1.0 $\mu$ F

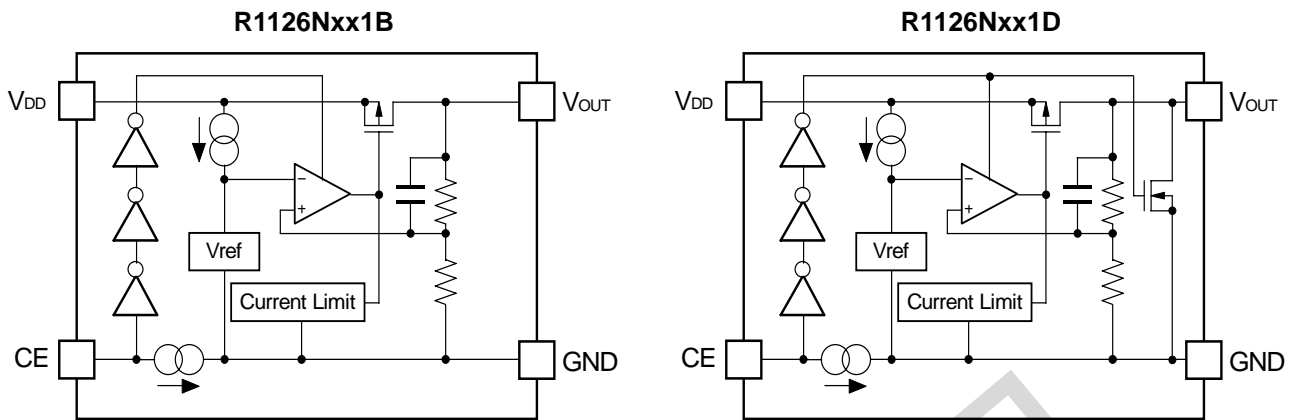
### ■ アプリケーション

- 携帯用通信機器、カメラ、ビデオの定電圧電源
- 携帯音楽プレーヤの定電圧源
- バッテリー使用機器の定電圧電源
- 家庭用電気製品の定電圧電源

# R1126N

生産終了品

## ■ ブロック図



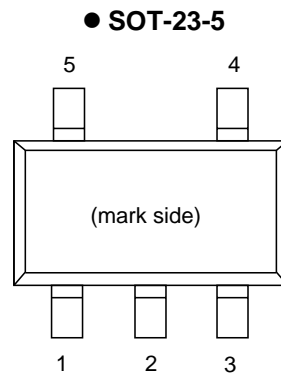
## ■ セレクションガイド

R1126Nシリーズは出力電圧、バージョン、テーピングを用途によって選択指定することができます。選択指定の方法はデバイスの型式番号を用いて下記のように行います。

R1126N $\overset{\uparrow}{a}$  $\overset{\uparrow}{b}$ xx1 $\overset{\uparrow}{c}$ x- $\overset{\uparrow}{d}$ xx ← 形式番号

番号	内容
a	パッケージの指定に用います。 N : SOT-23-5
b	出力電圧 (V <sub>OUT</sub> ) の指定に用います。 V <sub>OUT</sub> の指定は 1.5V~4.0V の範囲で 0.1V 単位にて指定可能です。 2.85V 品、1.85V 品については、R1126N281x5-xx、R1126N181x5-xx となります。
c	バージョン記号の指定に用います。 B : CE="H"アクティブ D : CE="H"アクティブ、Low 出力 Nch トランジスタ追加タイプ
d	テーピングの指定に用います。 TR 標準のみ (テーピング仕様参照)

## ■ 端子接続図



## ■ 端子説明

### ● R1126N

端子番号	端子名	機能
1	CE	チップイネーブル端子
2	GND	グラウンド端子
3	NC	ノーコネクション
4	V <sub>OUT</sub>	出力端子
5	V <sub>DD</sub>	入力端子

## ■ 絶対最大定格

記号	項目	定格値	単位
V <sub>IN</sub>	入力電圧	6.5	V
V <sub>CE</sub>	入力電圧 (CE 端子)	6.5	V
V <sub>OUT</sub>	出力電圧	-0.3~V <sub>IN</sub> +0.3	V
I <sub>OUT</sub>	出力電流	160	mA
P <sub>D</sub>	許容損失 (SOT23-5) (標準実装条件) *	420	mW
T <sub>opt</sub>	動作周囲温度	-40~85	°C
T <sub>stg</sub>	保存周囲温度	-55~125	°C

\*) 許容損失、標準実装条件については、後のパッケージ情報に詳しく記述していますので、参照下さい。

# R1126N

生産終了品

## ■ 電気的特性

### ● R1126Nxx1B/D

T<sub>opt</sub>=25°C

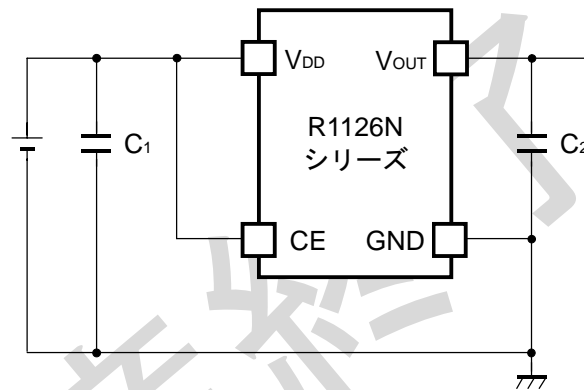
記号	項目	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位	
V <sub>OUT</sub>	出力電圧	V <sub>IN</sub> -V <sub>OUT</sub> =1.0V 1mA ≤ I <sub>OUT</sub> ≤ 30mA	V <sub>OUT</sub> ≤ 3.0V	×0.985		×1.015	V
			V <sub>OUT</sub> > 3.0V	×0.980		×1.020	
I <sub>OUT</sub>	出力電流	V <sub>IN</sub> -V <sub>OUT</sub> =1.0V	150			mA	
ΔV <sub>OUT</sub> /ΔI <sub>OUT</sub>	負荷安定度	V <sub>IN</sub> -V <sub>OUT</sub> =1.0V 1mA ≤ I <sub>OUT</sub> ≤ 150mA 1.5V ≤ V <sub>OUT</sub> < 2.0V 2.0V ≤ V <sub>OUT</sub> < 3.0V 3.0V ≤ V <sub>OUT</sub>		28 33 35	55 66 80	mV	
V <sub>DIF</sub>	入出力電圧差	出力電圧別電気的特性参照					
I <sub>SS</sub>	消費電流	V <sub>IN</sub> -V <sub>OUT</sub> =1.0V, I <sub>OUT</sub> =0mA		10	18	μA	
I <sub>standby</sub>	消費電流 (スタンバイ時)	V <sub>IN</sub> -V <sub>OUT</sub> =1.0V, V <sub>CE</sub> =GND		0.1	1.0	μA	
ΔV <sub>OUT</sub> /ΔV <sub>IN</sub>	入力安定度	I <sub>OUT</sub> =30mA V <sub>OUT</sub> +0.5V ≤ V <sub>IN</sub> ≤ 6.0V		0.02	0.10	%/V	
RR	リップル除去率	f=1kHz f=10kHz リップル 0.2Vp-p V <sub>IN</sub> -V <sub>OUT</sub> =1.0V, I <sub>OUT</sub> =30mA		70 53		dB	
V <sub>IN</sub>	入力電圧		1.8		6.0	V	
ΔV <sub>OUT</sub> /ΔT <sub>opt</sub>	出力電圧温度係数	I <sub>OUT</sub> =30mA -40°C ≤ T <sub>opt</sub> ≤ 85°C		±100		ppm /°C	
I <sub>lim</sub>	短絡電流	V <sub>OUT</sub> =0V		40		mA	
I <sub>PD</sub>	CE プルダウン定電流			0.5		μA	
V <sub>CEH</sub>	CE 入力電圧 "H"		1.0		6.0	V	
V <sub>CEL</sub>	CE 入力電圧 "L"		0.0		0.3	V	
en	出力雑音電圧	BW=10Hz~100kHz		30		μVrms	
R <sub>LOW</sub>	LOW 出力 Nch Tr. ON 抵抗 (Dバージョンのみ)	V <sub>CE</sub> =0V		70		Ω	

## ● 出力電圧別電気的特性

Topt=25°C

出力電圧 $V_{OUT}$ (V)	入出力電圧差 $V_{DIF}$ (V)		
	条件	TYP.	MAX.
$V_{OUT}=1.5$	$I_{OUT}=150\text{mA}$	0.54	0.86
$1.5\text{V} < V_{OUT} \leq 1.6\text{V}$		0.50	0.75
$1.6\text{V} < V_{OUT} \leq 1.7\text{V}$		0.46	0.70
$1.7\text{V} < V_{OUT} \leq 2.0\text{V}$		0.44	0.65
$2.0\text{V} < V_{OUT} \leq 2.7\text{V}$		0.37	0.56
$2.7\text{V} < V_{OUT} \leq 4.0\text{V}$		0.29	0.46

## ■ 基本回路例



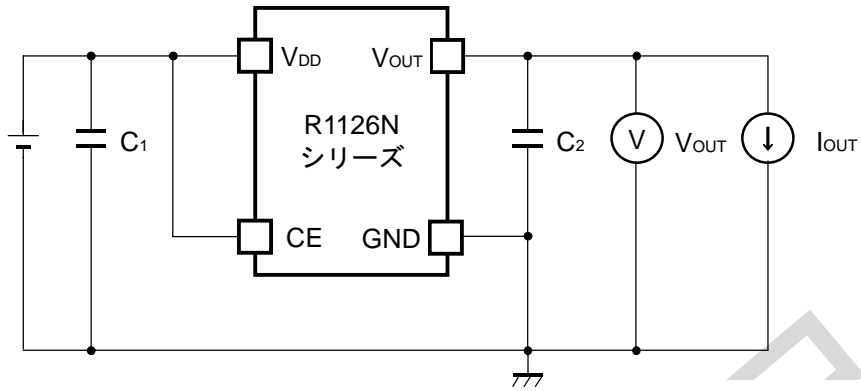
基本回路例

外付け部品参考例

$C_2$  : セラミックコンデンサ 1 $\mu\text{F}$  村田製作所製 GRM155B30J105KE18B  
京セラ製 CM05X5R105K06AB

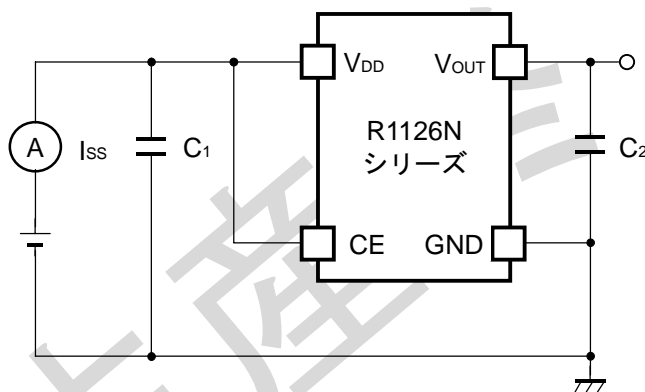
$C_1$  : セラミックコンデンサ 1 $\mu\text{F}$

■ 測定回路



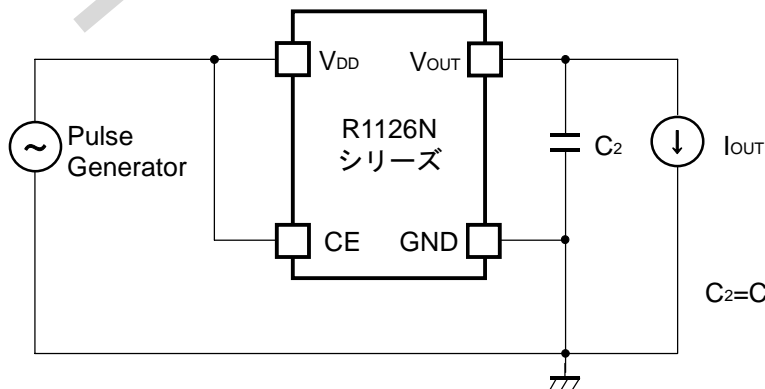
C1=Ceramic 1.0 $\mu$ F  
C2=Ceramic 1.0 $\mu$ F

基本測定回路



C1=Ceramic 1.0 $\mu$ F  
C2=Ceramic 1.0 $\mu$ F

消費電流測定回路

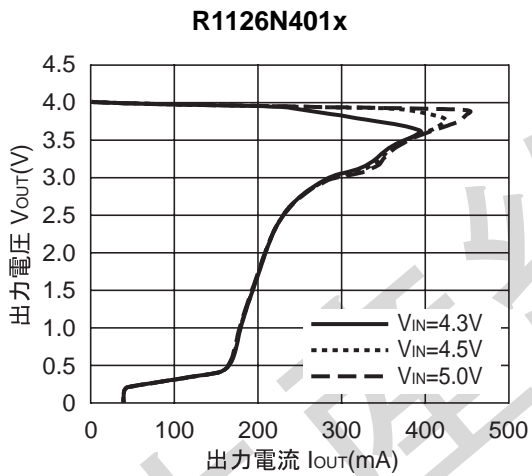
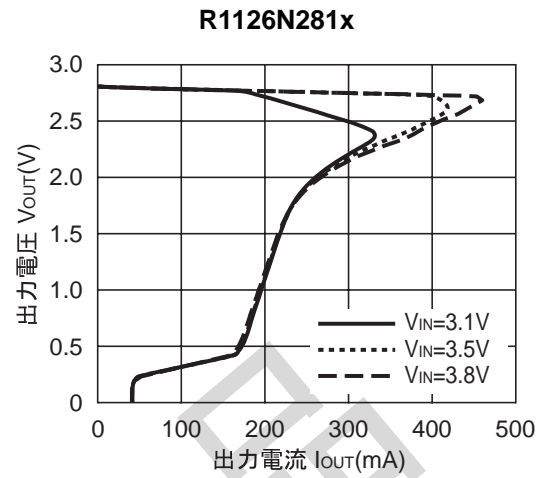
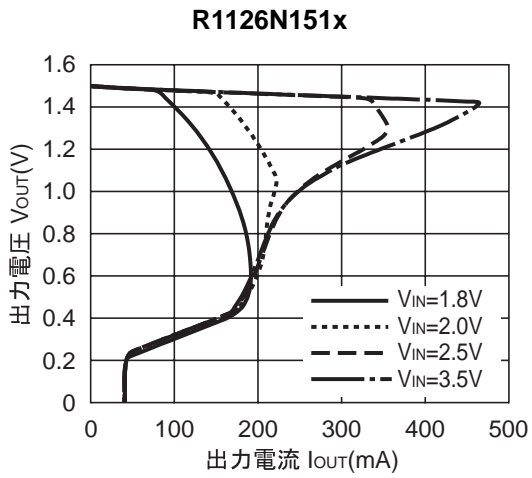


C2=Ceramic 1.0 $\mu$ F

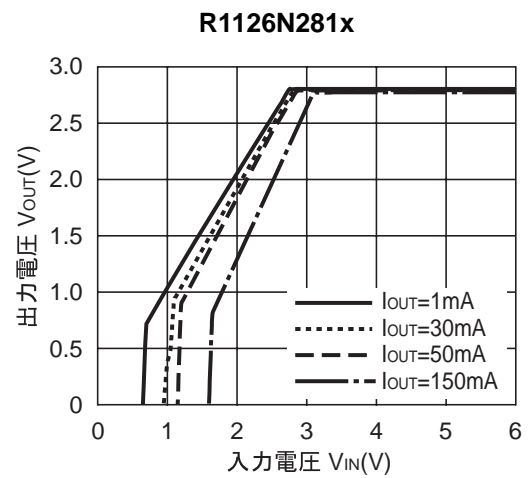
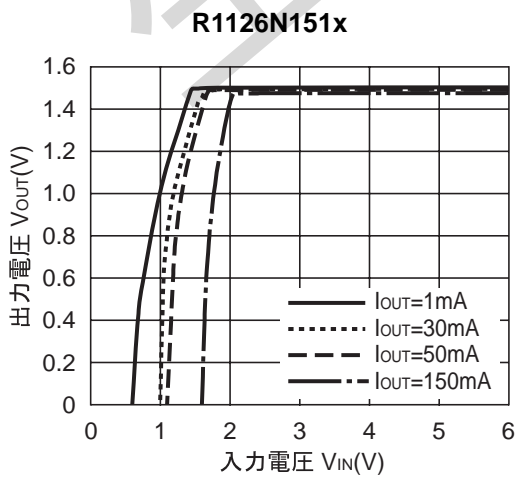
リップル除去率、入力過渡応答測定回路

## ■ 特性例

### 1) 出力電圧対出力電流特性例

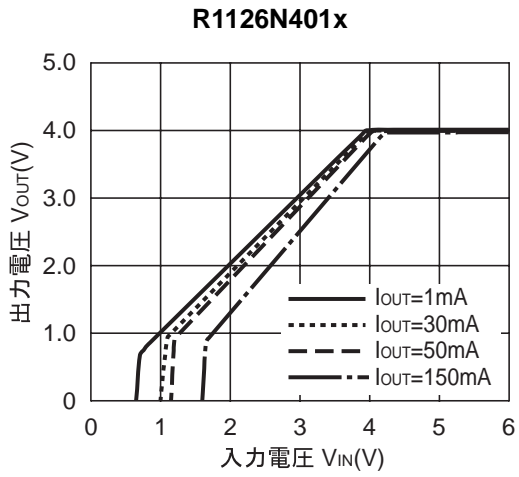


### 2) 出力電圧対入力電圧特性例

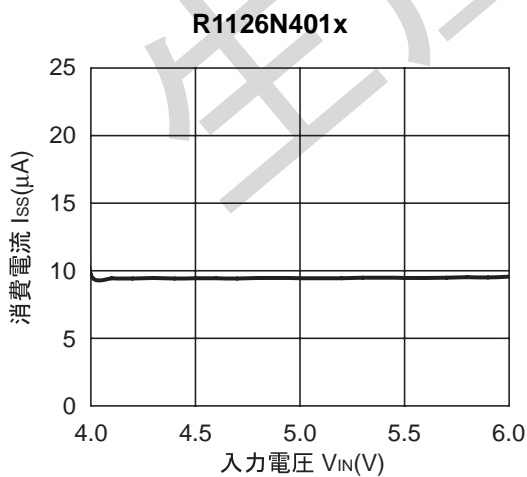
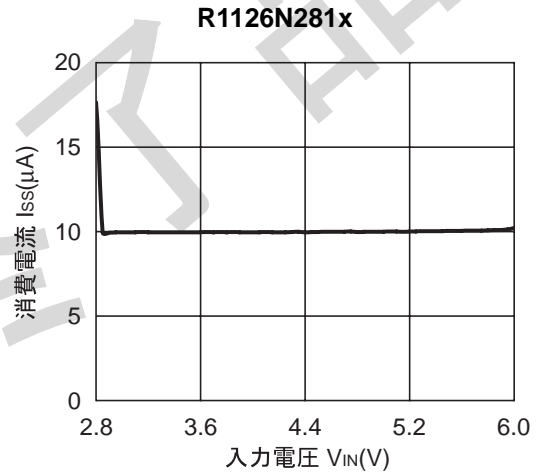
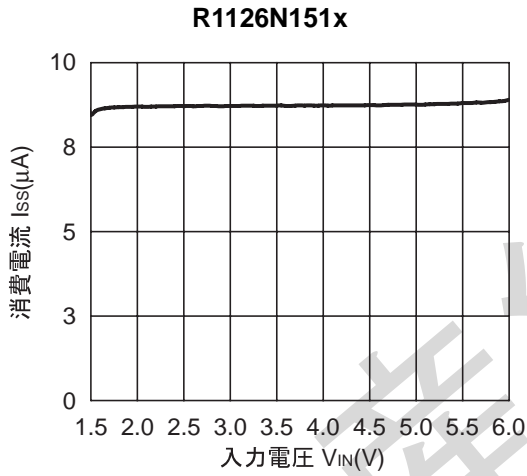


# R1126N

生産終了品

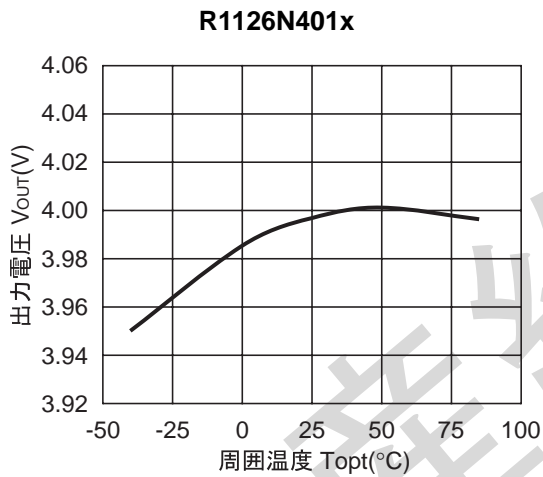
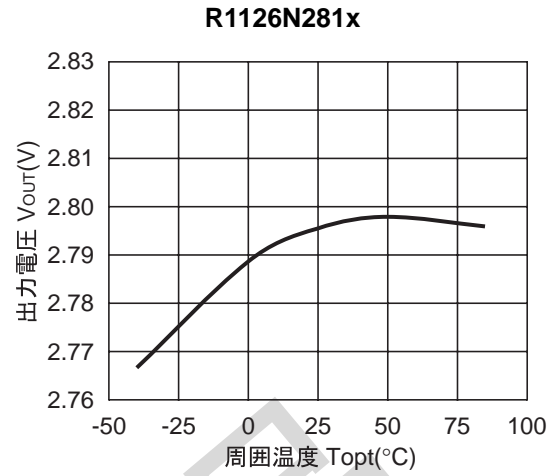
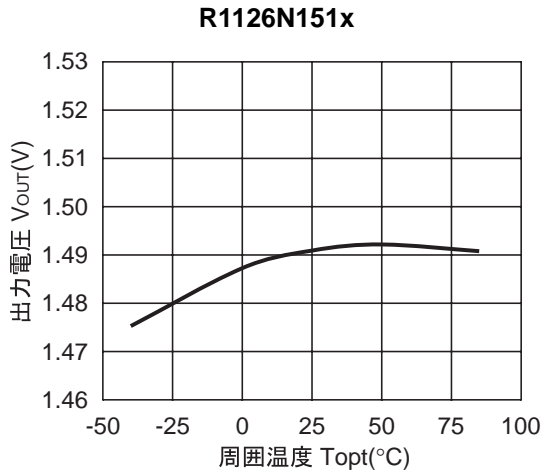


### 3) 消費電流対入力電圧特性例 (Topt=25°C)

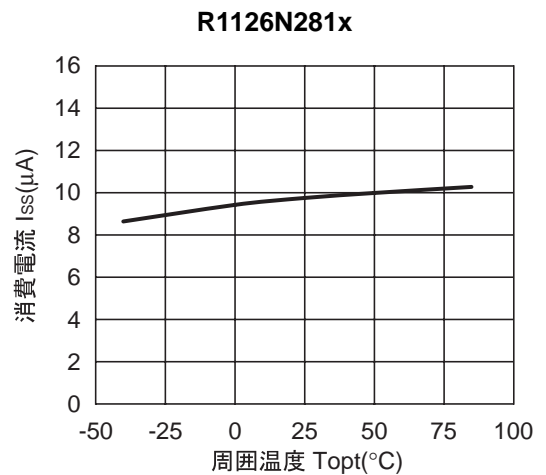
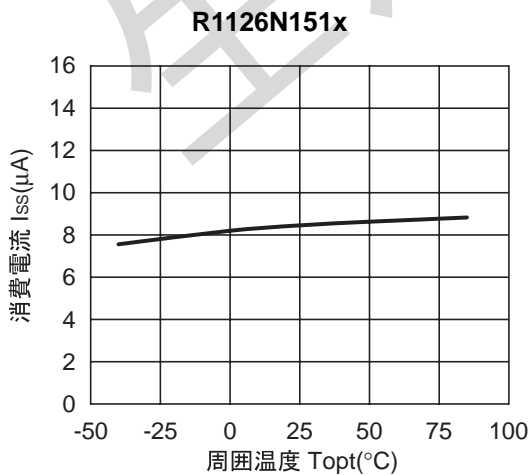




4) 出力電圧対周囲温度特性例



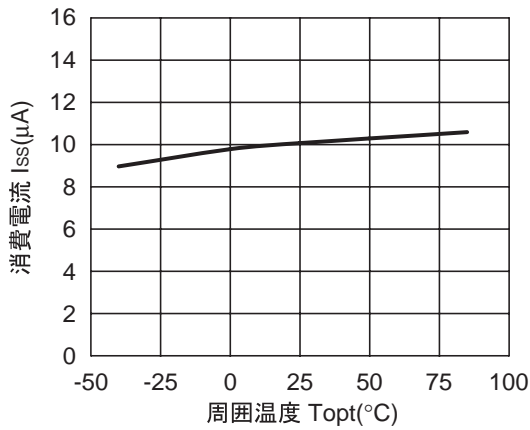
5) 消費電流対周囲温度特性例



# R1126N

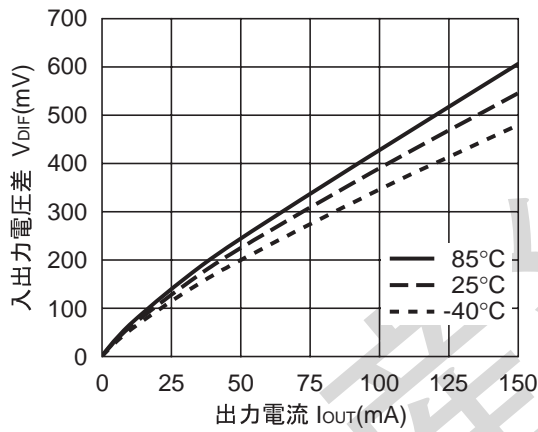
生産終了品

### R1126N401x

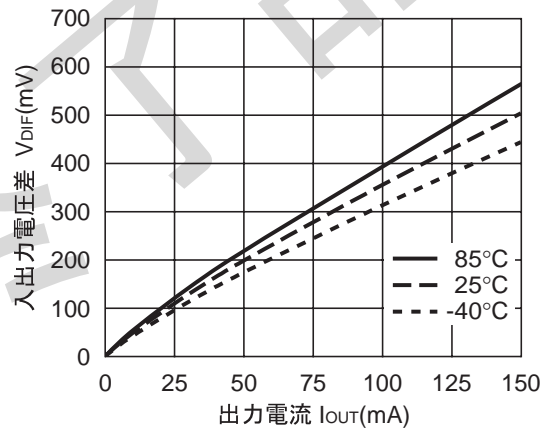


## 6) 入出力電圧差対出力電流特性例

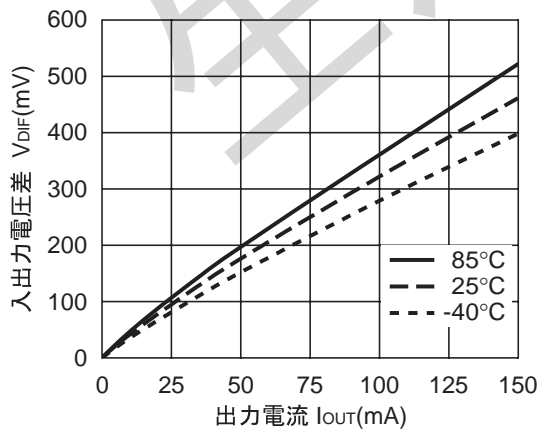
### R1126N151x



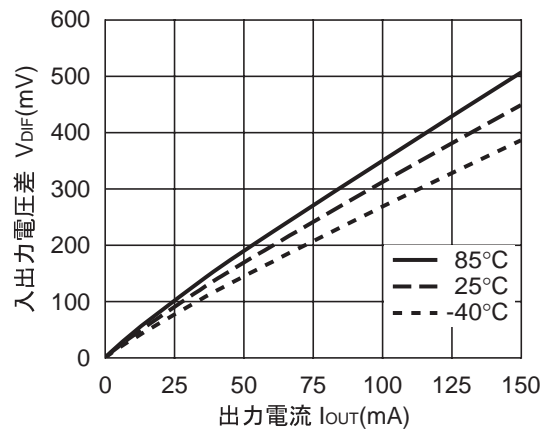
### R1126N161x

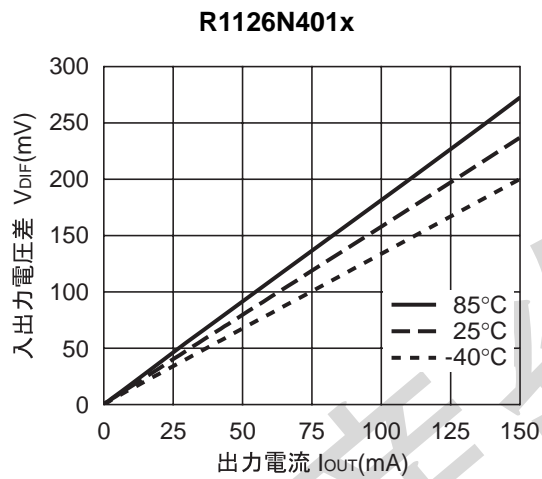
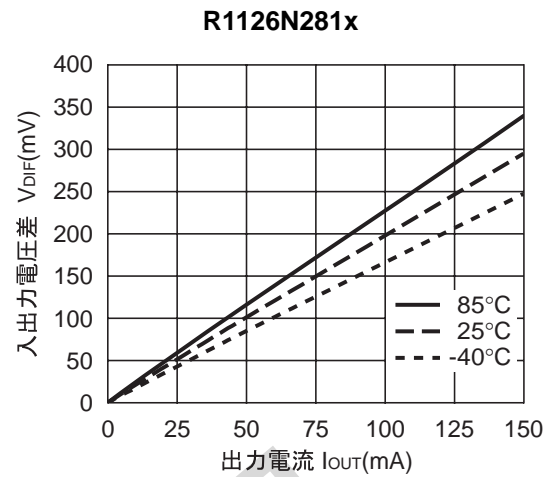
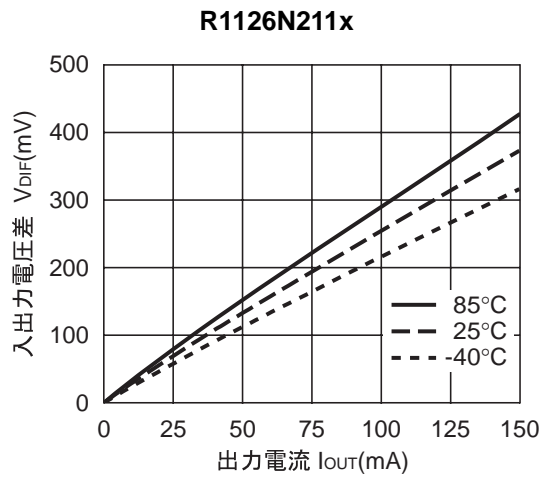


### R1126N171x

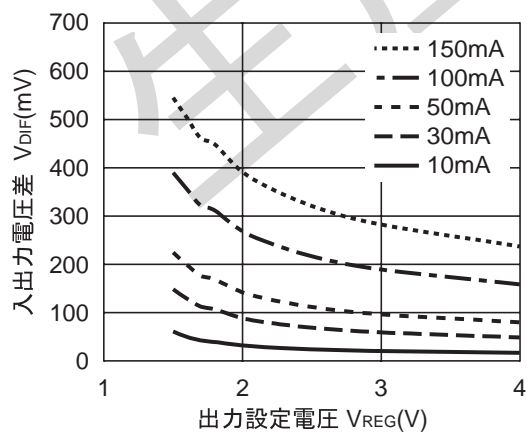


### R1126N181x





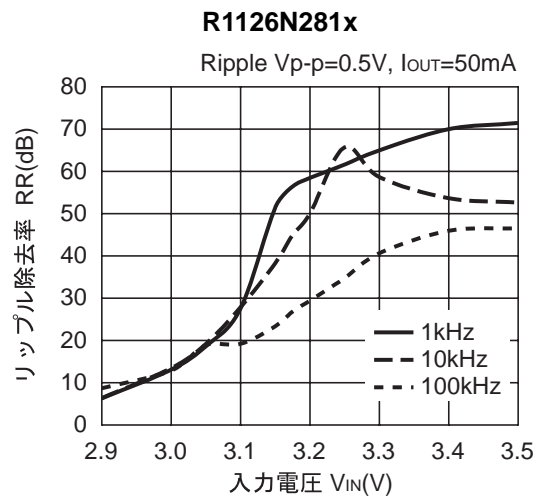
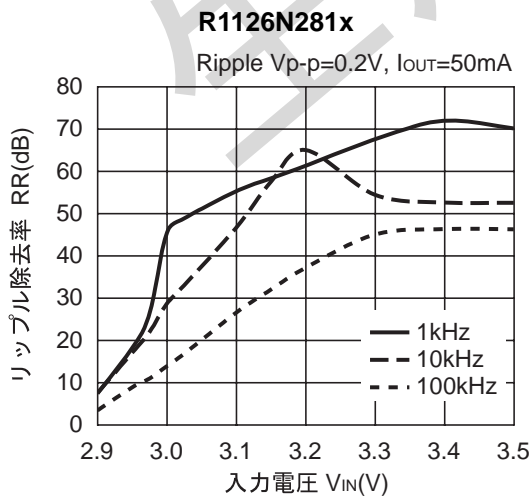
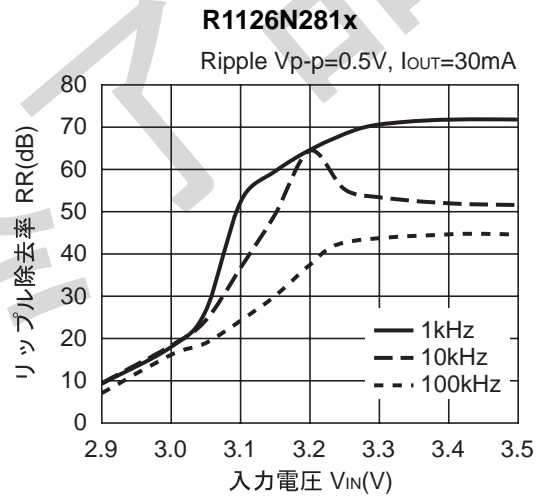
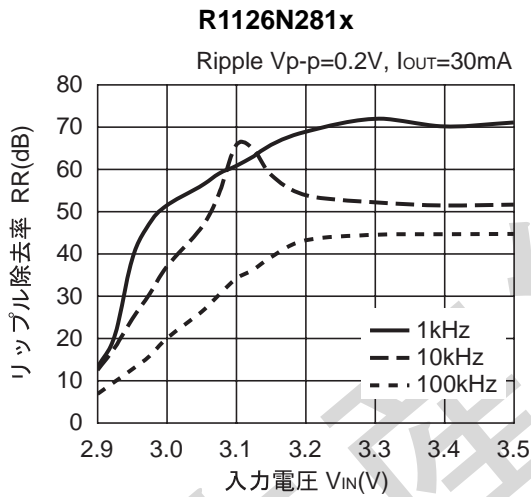
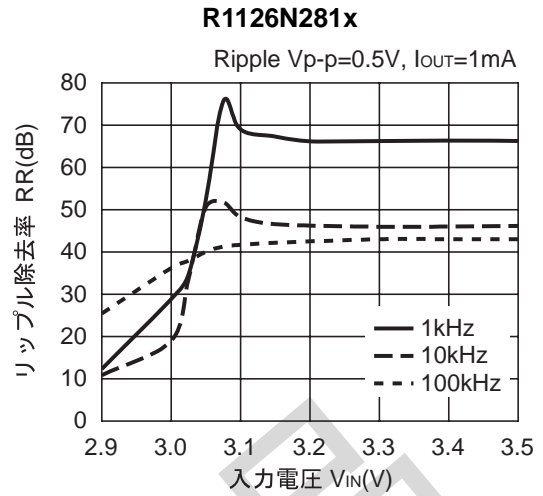
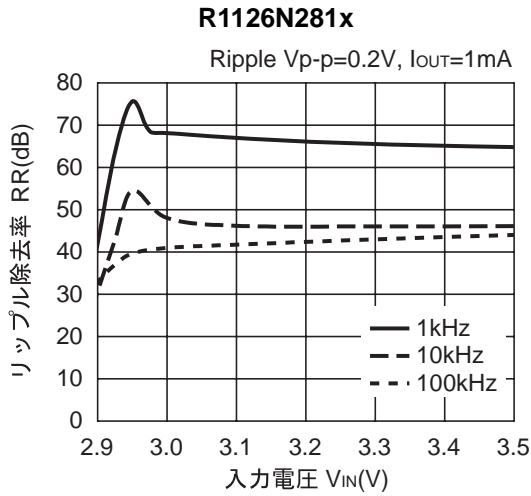
### 7) 入出力電圧差対出力設定電圧特性例 ( $T_{opt}=25^{\circ}\text{C}$ )



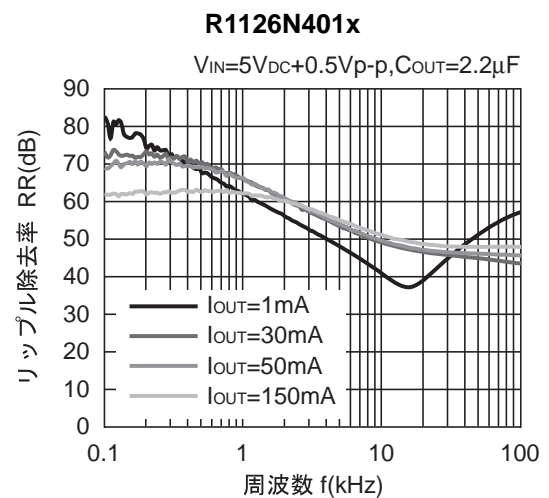
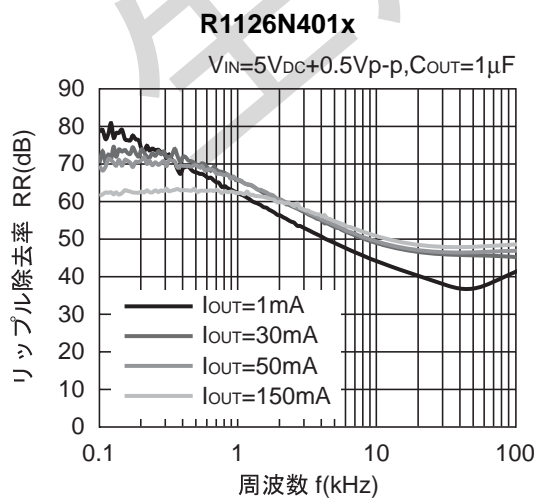
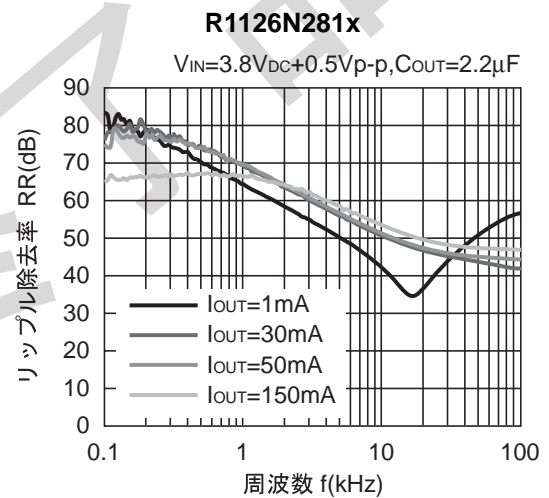
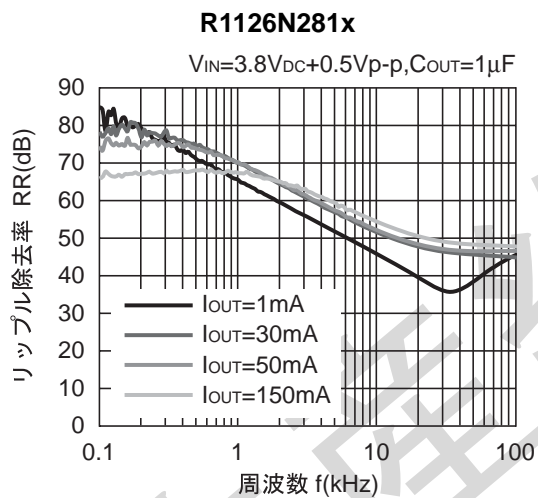
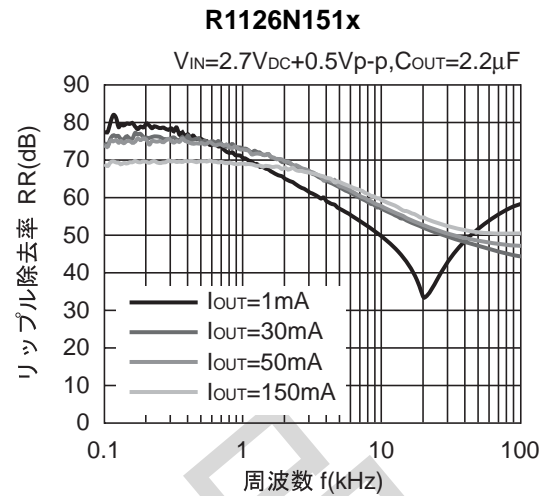
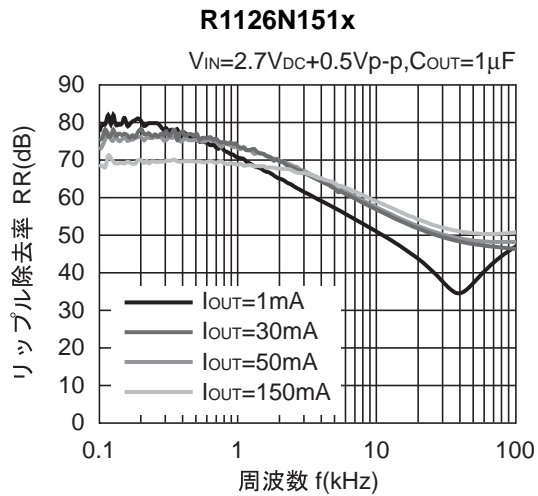
# R1126N

生産終了品

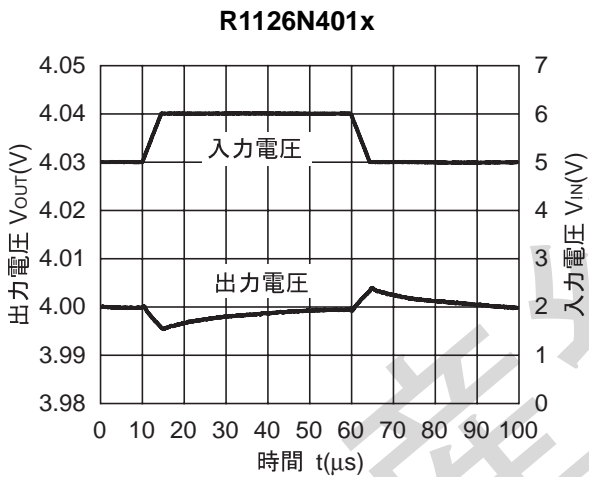
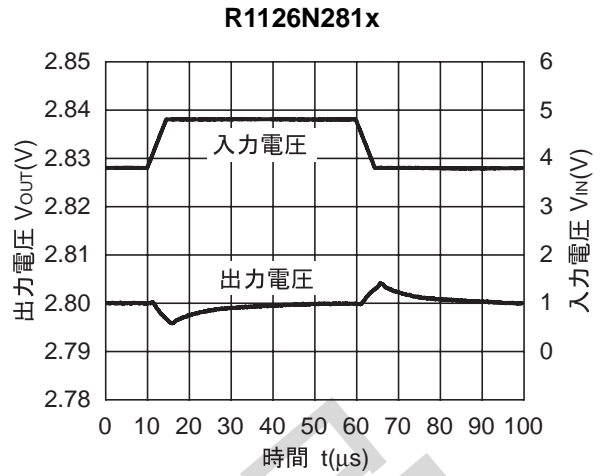
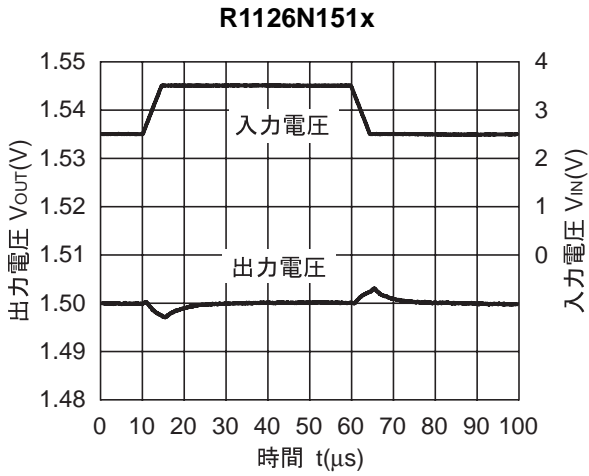
## 8) リプル除去率対入力バイアス電圧特性例 (Topt=25°C, CIN=none, COUT=1μF)



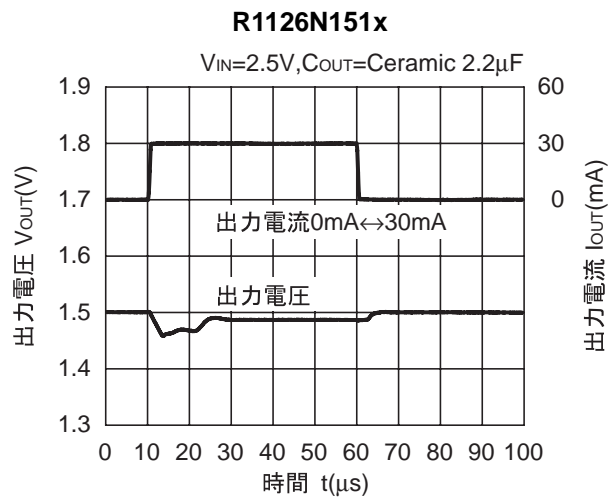
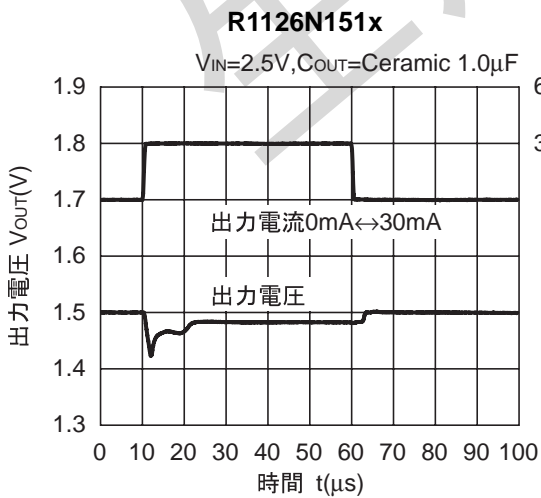
## 9) リプル除去率対周波数特性例

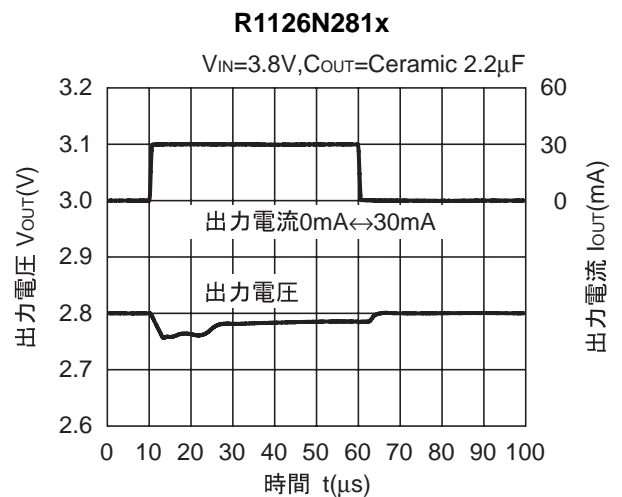
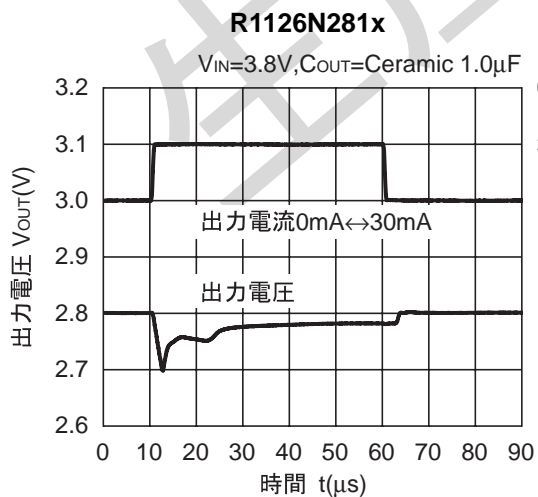
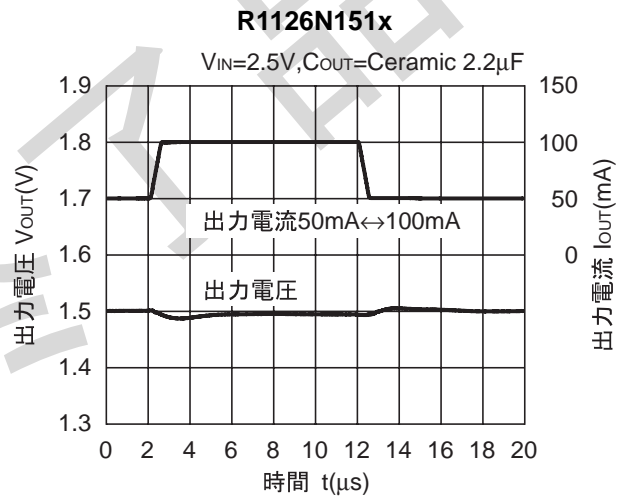
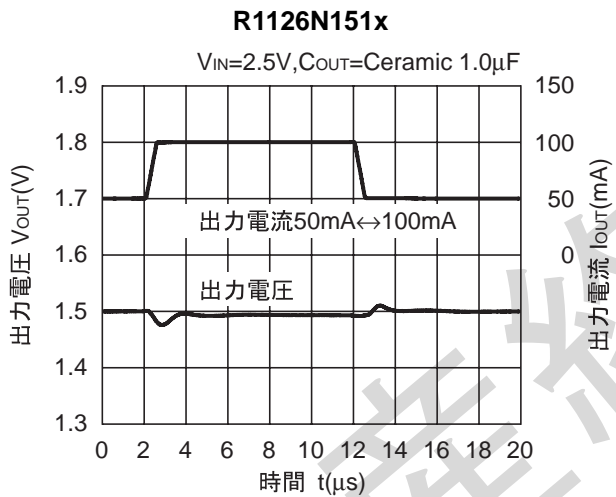
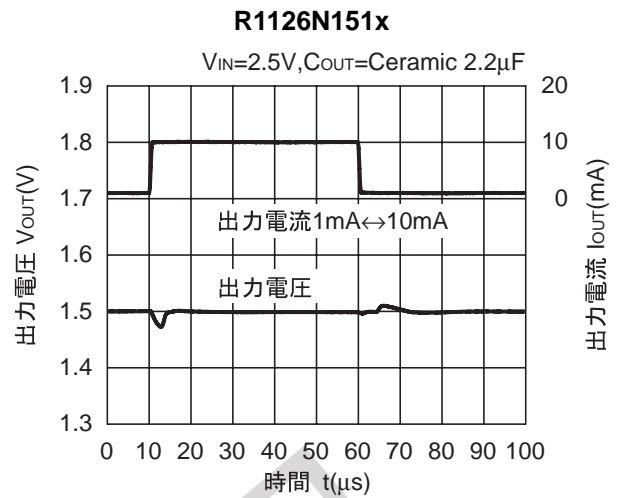
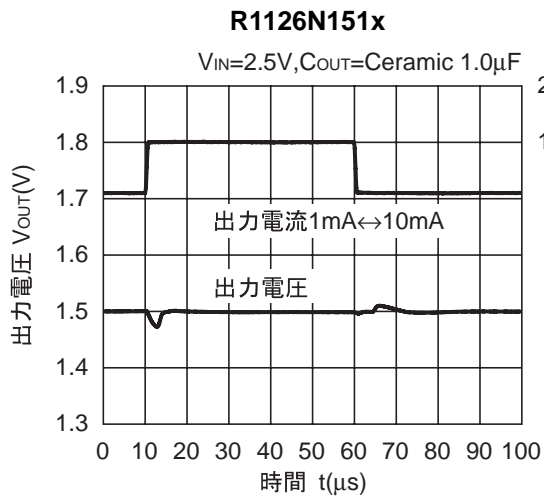


10) 入力過渡応答特性例 ( $I_{OUT}=30\text{mA}$ ,  $t_r=t_f=5\mu\text{s}$ ,  $C_{OUT}=1\mu\text{F}$ )



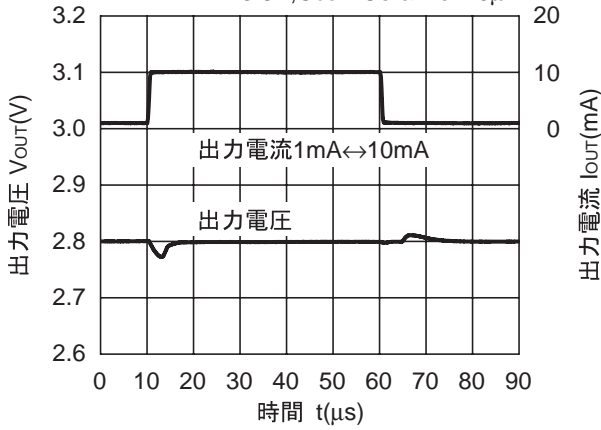
11) 負荷過渡応答特性例 ( $t_r=t_f=0.5\mu\text{s}$ ,  $C_{IN}=\text{Ceramic } 1\mu\text{F}$ )





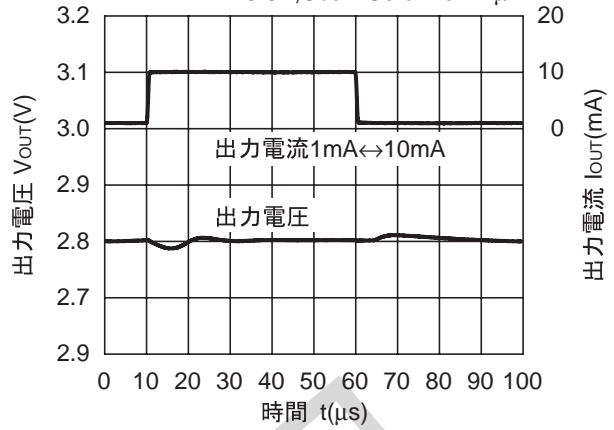
R1126N281x

V<sub>IN</sub>=3.8V, C<sub>OUT</sub>=Ceramic 1.0μF



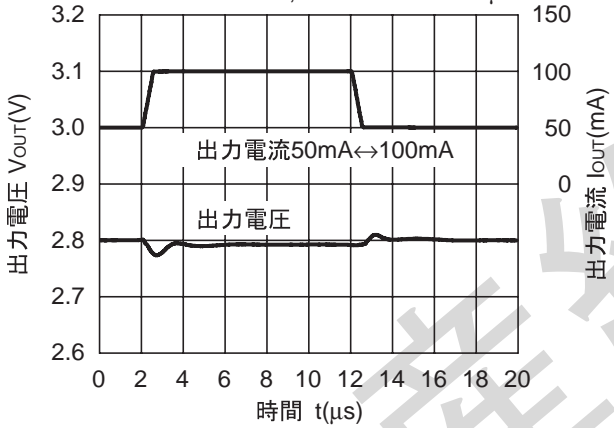
R1126N281x

V<sub>IN</sub>=3.8V, C<sub>OUT</sub>=Ceramic 2.2μF



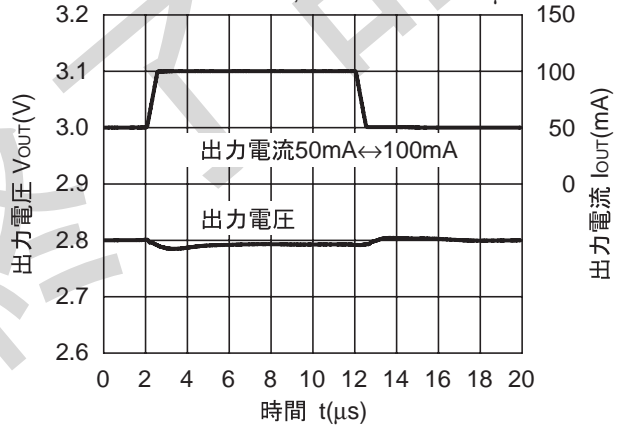
R1126N281x

V<sub>IN</sub>=3.8V, C<sub>OUT</sub>=Ceramic 1.0μF



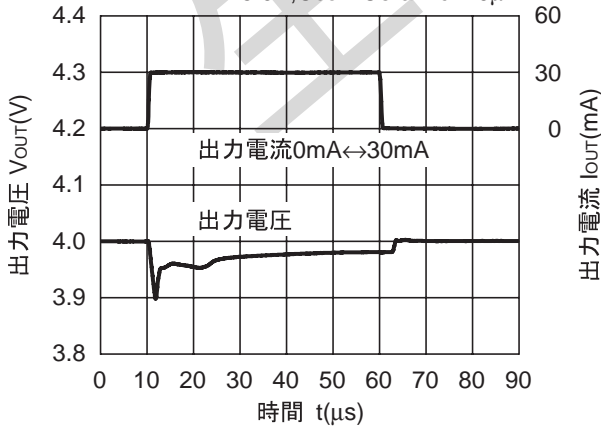
R1126N281x

V<sub>IN</sub>=3.8V, C<sub>OUT</sub>=Ceramic 2.2μF



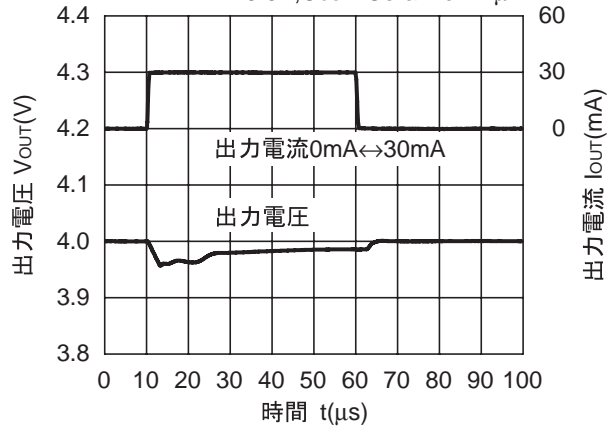
R1126N401x

V<sub>IN</sub>=5.0V, C<sub>OUT</sub>=Ceramic 1.0μF

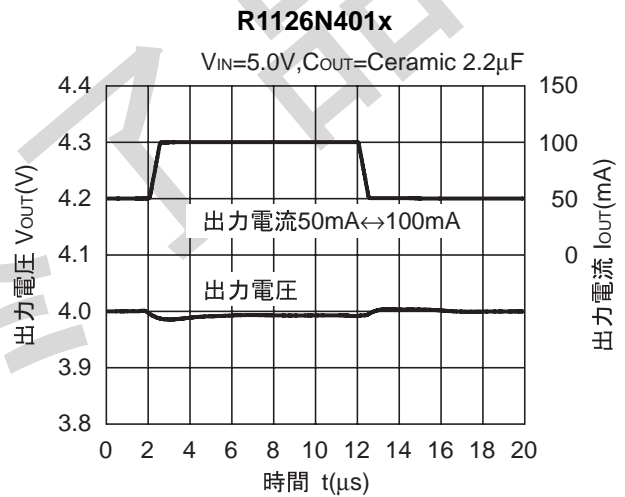
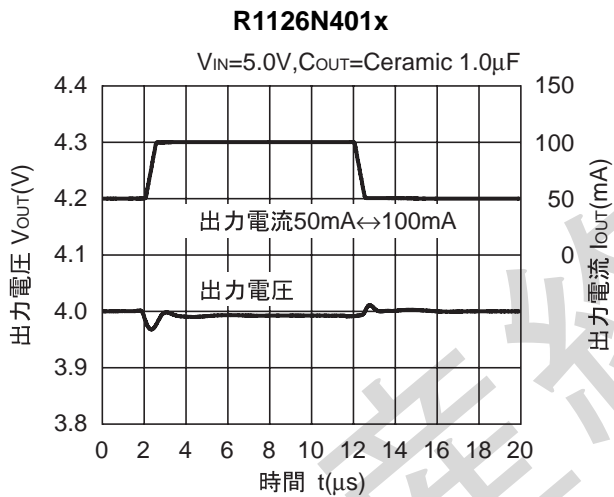
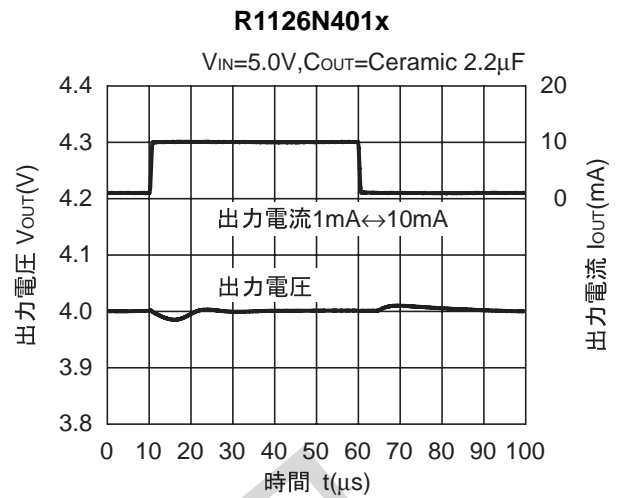
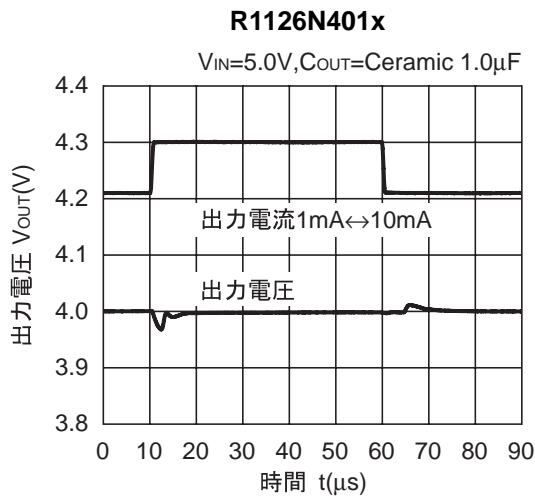


R1126N401x

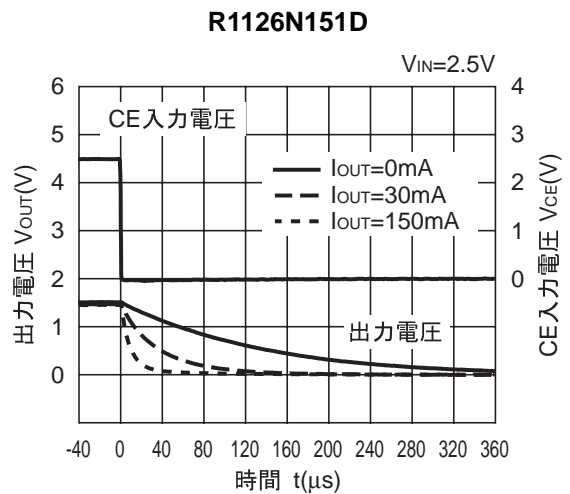
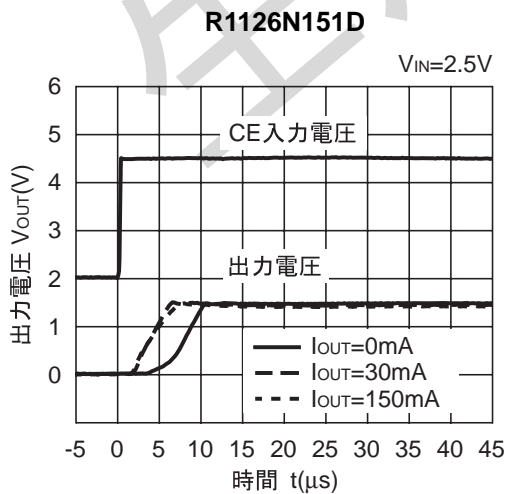
V<sub>IN</sub>=5.0V, C<sub>OUT</sub>=Ceramic 2.2μF



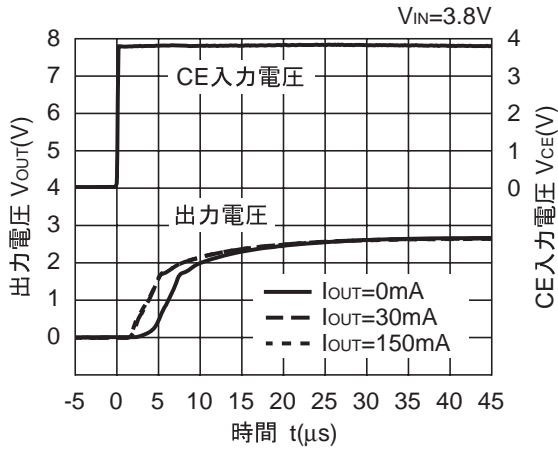




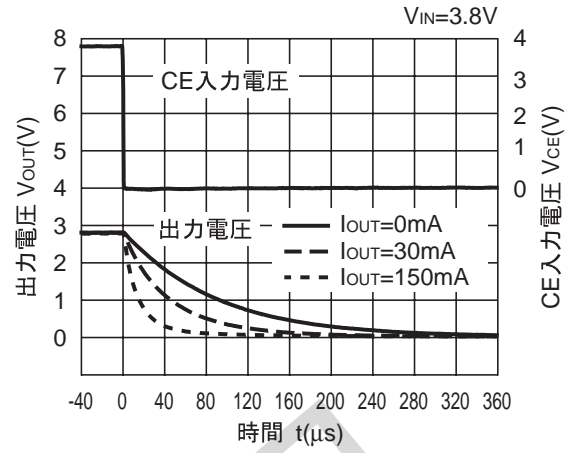
12) CE 立ち上がり/立ち下がり応答時間 D パージョン (CIN=Ceramic 1.0μF COUT=Ceramic 1.0μF)



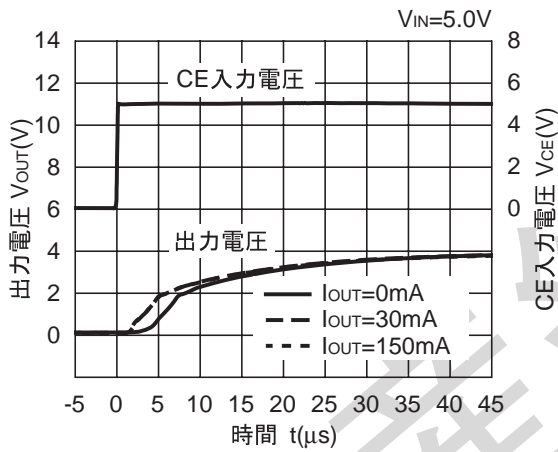
R1126N281D



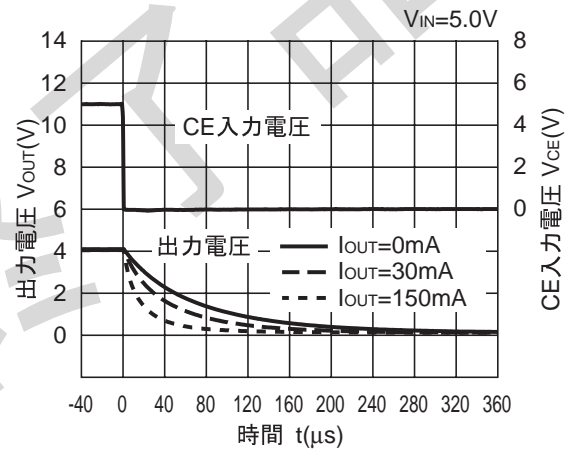
R1126N281D



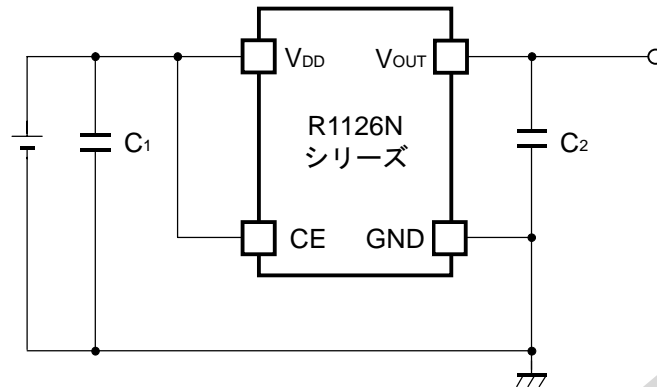
R1126N401D



R1126N401D



## ■ 外付部品に関する注意点



基本回路例

外付け部品参考例

C<sub>2</sub> : セラミックコンデンサ 1 $\mu$ F 村田製作所製 GRM155B30J105KE18B  
京セラ製 CM05X5R105K06AB

C<sub>1</sub> : セラミックコンデンサ 1 $\mu$ F

### 1. 基板実装について

V<sub>DD</sub>、および、GND配線はインピーダンスが高いとノイズのまわり込みや動作が不安定になる原因になるので充分強化して下さい。また、基本回路例のようにV<sub>DD</sub>端子-GND端子間に1.0 $\mu$ F程度以上のコンデンサC<sub>1</sub>をできるだけ配線が短くなるようにつけて下さい。

### 2. 位相補償について

本ICは、出力負荷が変化しても安定に動作させるために、出力段にて位相補償を行っています。

このため、周波数特性が良く、直列等価抵抗（ESR）の低いコンデンサC<sub>2</sub>をV<sub>OUT</sub>端子とGND端子間にできるだけ配線が短くなるようにつけて下さい。

以下に参考例としてノイズレベルが約40 $\mu$ V（平均値）以下になる負荷電流（I<sub>OUT</sub>）と出力側コンデンサのESRの範囲を網掛けで示します。

タンタルコンデンサを使用する場合は、ESRの値が大きいと出力が発振する可能性がありますので、周波数特性を含めて十分評価してください。

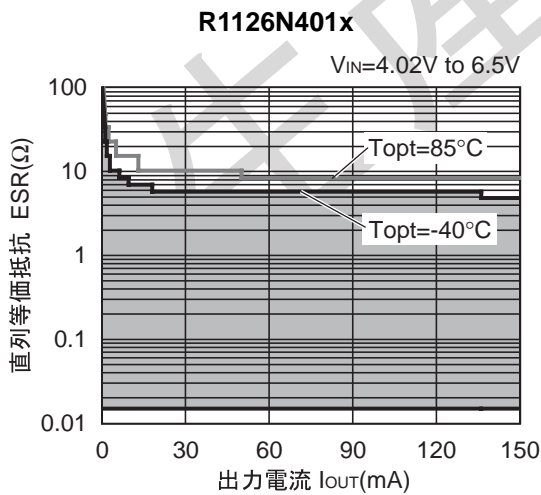
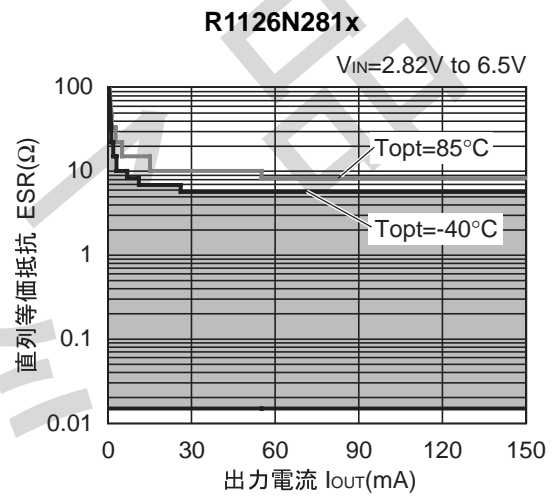
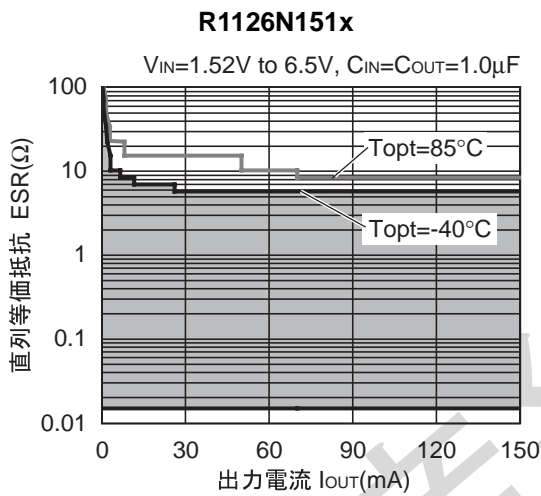
コンデンサのサイズ、製造元や品番により容量値のバイアス依存性や温度特性などが異なりますので、十分評価してください。

■ 直列等価抵抗値対出力電流特性例

本ICの出力コンデンサはセラミックタイプを推奨しますが、他の低ESRタイプのコンデンサも使用可能です。参考までに前項の回路で測定したノイズレベルが40μV(平均値)以下になる出力電流 $I_{OUT}$ と直列等価抵抗ESRの関係を示します。

測定条件

- ・  $V_{IN}=V_{OUT}+1V$
- ・  $C_{OUT}$ 使用チップコンデンサ : GRM155B30J105KE18B
- ・ ノイズ周波数帯域 : 10Hz~1MHz
- ・ 測定温度 : 25°C
- ・ 網掛け部分 : ノイズレベルが40μV(平均値)以下





本ドキュメント掲載の技術情報及び半導体のご使用につきましては以下の点にご注意ください。

1. 本ドキュメントに記載しております製品及び製品仕様は、改良などのため、予告なく変更することがあります。又、製造を中止する場合がありますので、ご採用にあたりましては当社又は販売店に最新の情報をお問合せください。
2. 文書による当社の承諾なしで、本ドキュメントの一部、又は全部をいかなる形でも転載又は複製されることは、堅くお断り申し上げます。
3. 本ドキュメントに記載しております製品及び技術情報のうち、「外国為替及び外国貿易管理法」に該当するものを輸出される場合、又は国外に持ち出される場合は、同法に基づき日本国政府の輸出許可が必要です。
4. 本ドキュメントに記載しております製品及び技術情報は、製品を理解していただくためのものであり、その使用に関して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証、又は実施権の許諾を意味するものではありません。
5. 本ドキュメントに記載しております製品は、標準用途として一般的電子機器(事務機、通信機器、計測機器、家電製品、ゲーム機など)に使用されることを意図して設計されております。故障や誤動作が人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼす恐れのある特別な品質、信頼性が要求される装置(航空宇宙機器、原子力制御システム、交通機器、輸送機器、燃焼機器、各種安全装置、生命維持装置等)に使用される際には、必ず事前に当社にご相談ください。
6. 当社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生します。故障の結果として人身事故、火災事故、社会的な損害等を生じさせない冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等安全設計に十分ご注意ください。誤った使用又は不適切な使用に起因するいかなる損害等についても、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
7. 本ドキュメントに記載しております製品は、耐放射線設計はなされてございません。
8. X線照射により製品の機能・特性に影響を及ぼす場合があるため、評価段階で機能・特性を確認の上でご利用ください。
9. WLCSPパッケージの製品は、遮光状態でご利用ください。光照射環境下(動作、保管中含む)では、機能・特性に影響を及ぼす場合があるためご注意ください。
10. パッケージ捺印は、画像認識装置の仕様によって文字認識に差が生じることがあります。画像認識装置にて文字認識をする場合は、事前に弊社販売店または弊社営業担当者までお問い合わせください。
11. 本ドキュメント記載製品に関する詳細についてのお問合せ、その他お気付きの点がございましたら当社又は販売店までご照会ください。



当社は地球環境保全の観点から環境負荷物質の低減に取り組んでいます。

2006年4月1日以降、弊社はRoHS指令に適合した製品を提供しています。また、2012年4月1日以降は、ハロゲンフリー製品を提供しています。

**RICOH** リコー電子デバイス株式会社

弊社デバイスに関する詳しい内容をお知りになりたい方は下記へアクセスしてください。

<http://www.e-devices.ricoh.co.jp/>

本ドキュメント掲載製品に関するお問い合わせは下記宛までお願いします。

- 東日本地区 〒140-8655 東京都品川区東品川3-32-3  
03(5479)2854 (直) FAX 03(5479)0502
- 西日本地区 〒563-8501 大阪府池田市姫室町13-1  
072(748)6262 (直) FAX 072(753)2120

●お問い合わせ・ご用命は・・・